



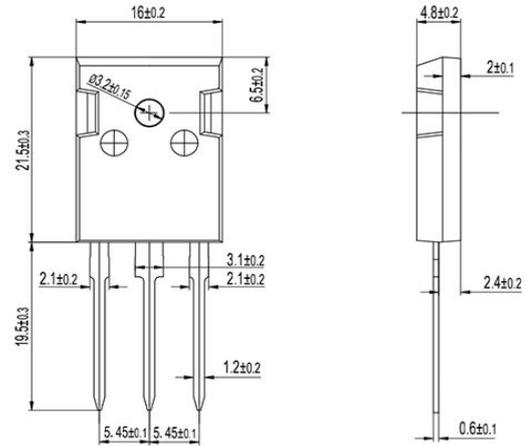
HSDQ BCA55A, BCB 55A 单向可控硅

TO-247

● 产品特征和主要用途:

PNP 四层结构的硅双向器件；具有自主知识产权的单面挖槽技术，台面玻璃钝化工艺；背面多层金属化电极；具有较高的阻断电压和较高的温度稳定性；

主要用于：加热控制器（调温）；彩灯控制器；固态继电器；吸尘器、电动工具等马达调速控制器；其它相控电路。



● 极限参数

符号	参数名称		数值	单位
$I_{T(RMS)}$	通态方均根电流	BCA BCB	$T_c=80^\circ\text{C}$ $T_c=90^\circ\text{C}$	55 A
I_{TSM}	通态浪涌电流	F=50HZ	t=20ms	600 A
I^2t	I^2t 的极限值	tp=10ms		1800 A^2S
di/dt	通态电流临界上升率	$T_j=125^\circ\text{C}$		100 A/us
V_{DRM}/V_{RRM}	断态重复峰值电压 反向重复峰值电压	$T_j=25^\circ\text{C}$		800 V
I_{GM}	门极峰值电流	tp=20us	$T_j=125^\circ\text{C}$	8 A
$P_{G(AV)}$	门极平均耗散功率		$T_j=125^\circ\text{C}$	1 W
T_{stg} T_j	储存温度 有效结温		-40to+150 -40to+125 $^\circ\text{C}$	



HSDQ BCA55A, BCB 55A 单向可控硅

●电特性

符号	名称和测试条件	象 限		数值	单位
I_{GT}	触发电流 $V_D=12V$ $R_L=100\Omega$ 触发电压	I	MAX	40	mA
V_{GT}			MAX	1.5	V
V_{GD}	不触发电压 $T_j=125^\circ C$		MIN	0.2	V
I_H	维持电流 $I_T=0.5A$		MAX	60	mA
I_L	擎住电流 $I_G=1.2I_{GT}$	I	MAX	80	mA
dv/dt	断态电压临界上升率 $V_D=2/3V_{DRM}$ $T_j=125^\circ C$		MIN	1000	V/us
(dv/dt)c	换向电压临界上升率 $T_j=125^\circ C$		MIN	10	V/us

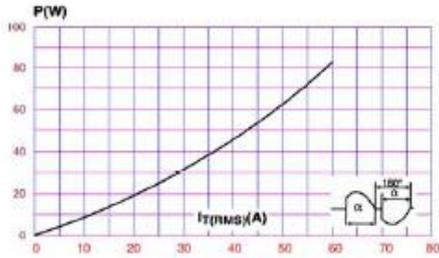
●静态参数

符号	名称和测试条件			数值	单位
V_{TM}	通态峰值电压 $I_{TM}=150A$	$T_j=25^\circ C$	MAX	1.50	V
V_{T0}	门槛电压	$T_j=125^\circ C$	MAX	0.86	V
R_d	斜率电阻	$T_j=125^\circ C$	MAX	6.4	m Ω
I_{DRM} I_{RRM}	断态峰值电流 反向峰值电流	$T_j=25^\circ C$	MAX	10	μA
		$T_j=125^\circ C$		2	mA
$R_{th(j-c)}$	结壳热阻	BTA		0.9	$^\circ C/W$
		BTB		0.6	

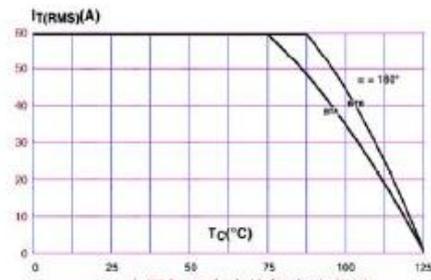


HSDQ BCA55A, BCB 55A 单向可控硅

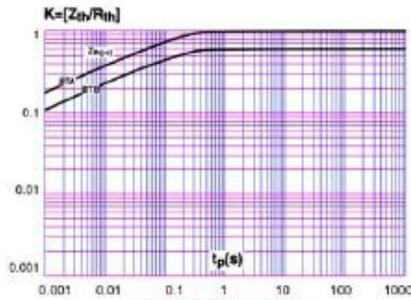
BCA55A, BCB55A 特性曲线



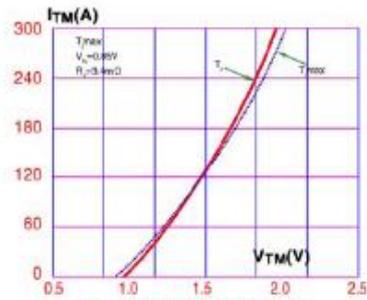
1、功耗与电流曲线 (180°)



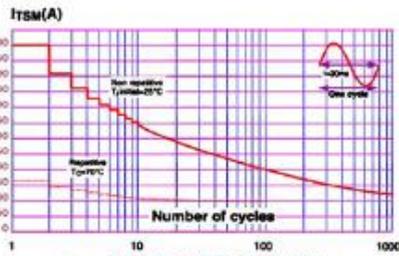
2、壳温与通态方均根电流曲线



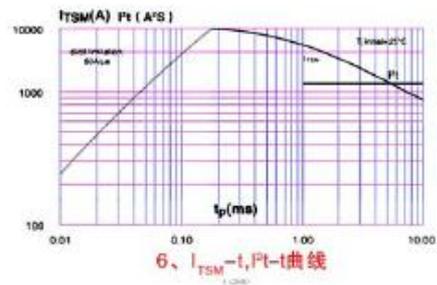
3、瞬态热阻曲线



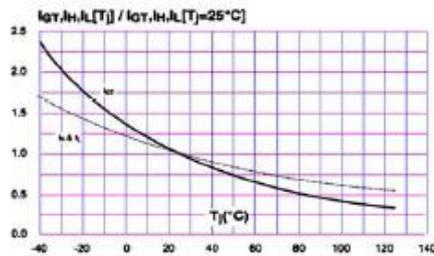
4、通态伏安特性曲线



5、浪涌电流与周波数曲线



6、 $I_{TSM}-t_p, I_{TSM}-t_p-t$ 曲线



7、门极触发特性曲线